TRANSISTORI

Wednesday, March 8, 2017

3:20 PI

dispositivi a 3 Terminali

- > funzionano da generatori controllati di corrente
- 1. La corrente tra due Terminali viene controllata
 della TENSIONE applicata al terzo terminate

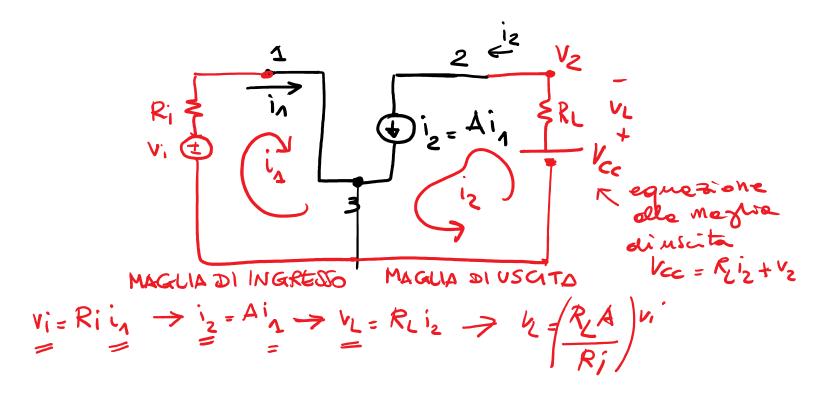
 (di controllo)

 [TRANSISTORE & EFFETTO DI CAMPO]
- 2. La corrente tra due terminali viene controllata
 della CORCENTE iniettata hel terzo terminale
 (di ontrolla)

 TRANSISTORE BIPO CARE A GIUNZIONE]

c

generatore di corrente controllato Wednesday, March 8, 2017 3:25 PM du corrente



Wednesday, March 8, 2017 3:31 PM

Potenza erogata dal generatore di ingresso $P_1 = v_1 i_2 = \frac{v_1^2}{R_1}$

Potenza assorbita dal carico (RC)

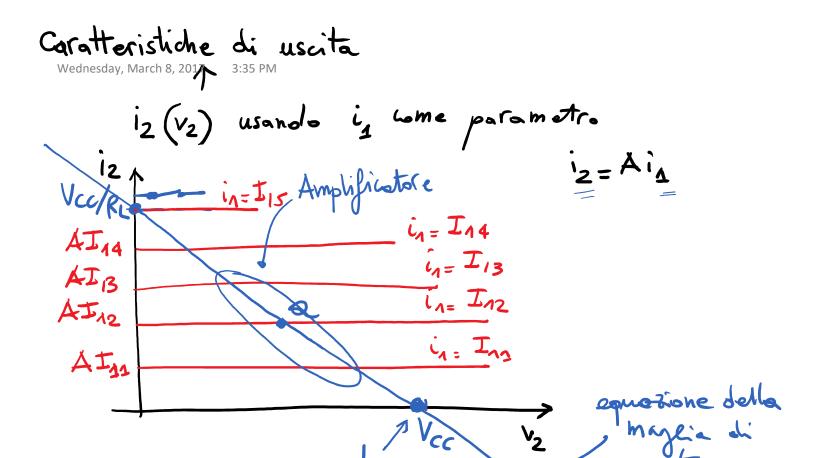
$$P_{\mu}: \frac{\sqrt{2}}{R_{L}} = \frac{\left(\frac{R_{L}}{R_{i}}\right)^{2} \frac{2}{N_{L}}}{R_{L}}$$

Amplificatione di petenza

Pu = RLA se Pu>1

Pi = Pi

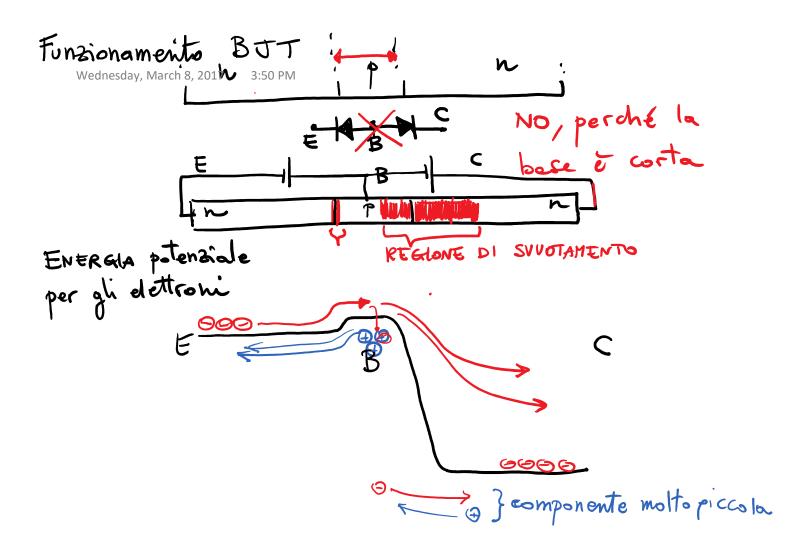
$$se \frac{p_u}{p_i} > 1$$



Page 4

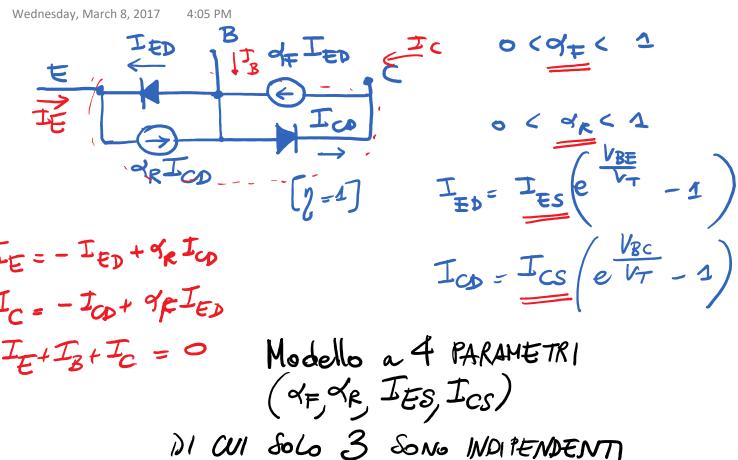
RETTA DI GARICO

TRANSISTORE BIPOLARE A GIUNZIONE Bipolar Junction Transistor · BJT] h EMETITIORE EMITTER BJT



FLUSSI DI CARICA IN UN BUTT Wednesday, March 8, 2017 3:58 PM in ZONA ATTIVA DIRETTA | 18t>0 18c <0] - PIÙ PICCOLA PERCHÈ LA BASE È MENO DROGATA DELL'EMENTITORE in bese CORRENTE DI SATURAZIONE (-) J INVERSA DELLA GIUNZIONE BC

Modello di EBERS e MOLL



Condizione di reciposcità Wednesday, March 8, 2017 4:13 PM

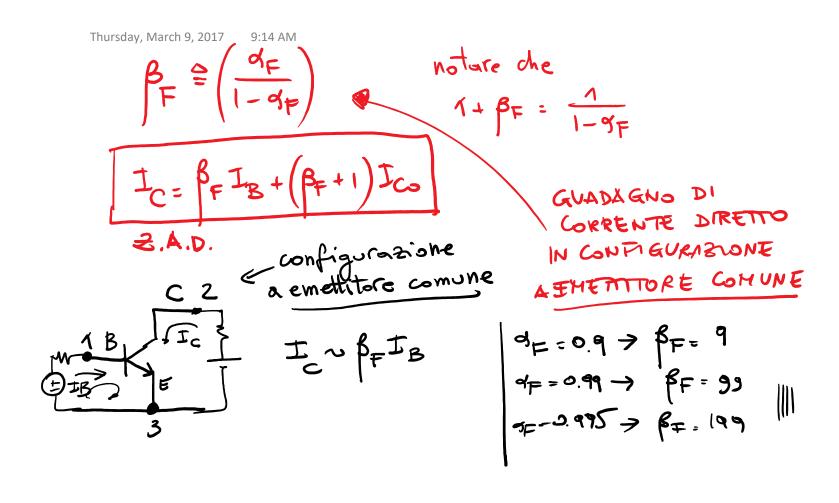
×

X

Poniamo VEE=0 Thursday, March 9, 2017 9:00 AM IED IED = 0 E IE = YR Ico INVERSO GUADAGNO DI CORRENTE Ia: - Ico DICOKTO CIRCUITO, VBE=0 Roverse short circuit wront gain 9p = 0.4 + 0.6

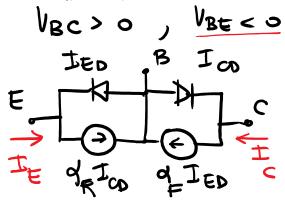
Regioni di funzionamento del BIT

32AD Zona Attiva Diretta



Zona Attiva Inversa

Thursday, March 9, 2017 9:21 AM



$$I_{ED} = -I_{ES}$$

$$I_{E} = I_{ES} + \forall R I_{CD}$$

$$I_{C} = -I_{CD} - \forall r I_{ES}$$

$$I_{E} = I_{ES} - \forall R I_{C} - \forall r \forall R I_{ES}$$

$$I_{E} = I_{ES} - \forall R I_{C} - \forall r \forall R I_{ES}$$

$$I_{E} = -\forall R I_{C} + I_{ES} (1 - \forall r \forall R)$$

$$I_{E} = I_{E} - I_{R}$$

$$I_{E} = I_{E} - I_{E}$$

$$I_{E$$

Thursday, March 9, 2017

9:28 AM

$$\frac{dR}{1-qR} \rightarrow I_{E} = \beta_{R}I_{2} + (\beta_{R}+1)I_{E}o$$

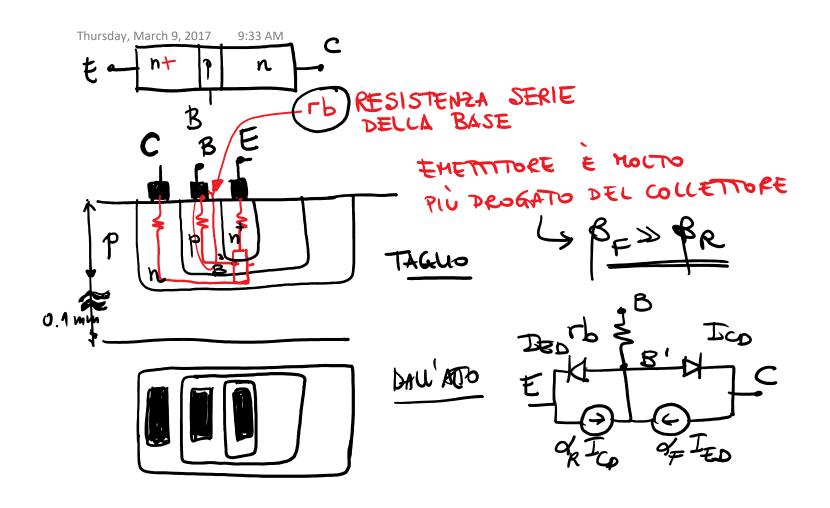
$$\frac{d}{d}$$

$$I_{E} \sim \beta_{R}I_{B}$$

B GUADAGNO INVERSO DI CORRENTE
IN CONFIGURAZIONE A COLLETTORE
COMUNE

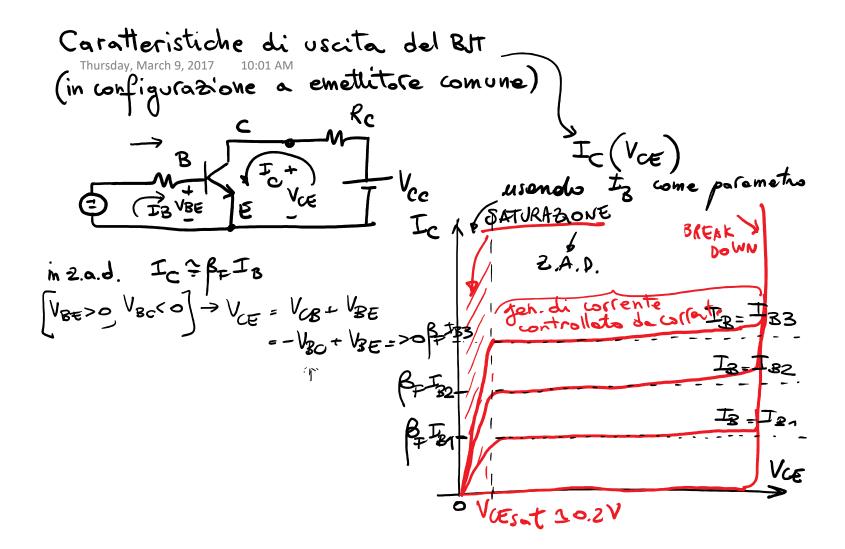
$$9R = 0.6 \rightarrow R = 1.5$$

 $9R = 0.4 \rightarrow R = 0.67$



REGIONI DI FUNZIONAMENTO DEL BOT

Thursday, Mar	rch 9, 2017 ·VBE ·	9:41 AM VBC	E n p n C
ZONA ATTIVA DIRETTA	>0	< 0	ELETTRONI O T F B (
ZONA ATTIVA INVERSA	<0	>0	E. pot. ELETTRONI O TE= BTB+ (B+1)TEO
SATURAZIONE (SATURATION)	>0	>0	UN ON
INTERDIZIONE (CUT OFF)	<0	<0	Un SC OFF



Thursday, March 9, 2017 10:11 AM E B 2.A.D. Value base si reshinge aumento Vce

se aumento VŒ

eumenta la

zona di svuotamento

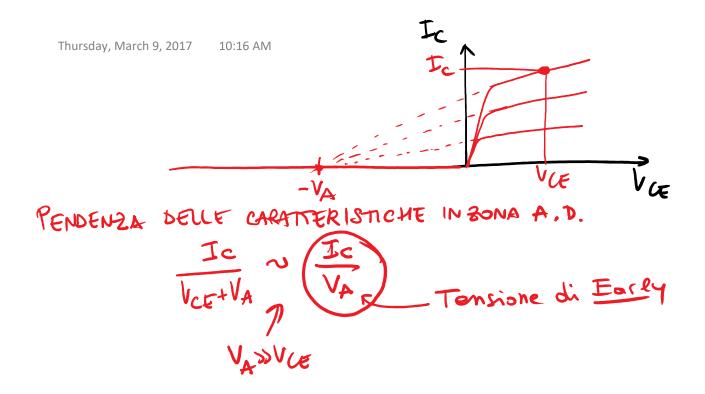
tha B e C

si restringe la

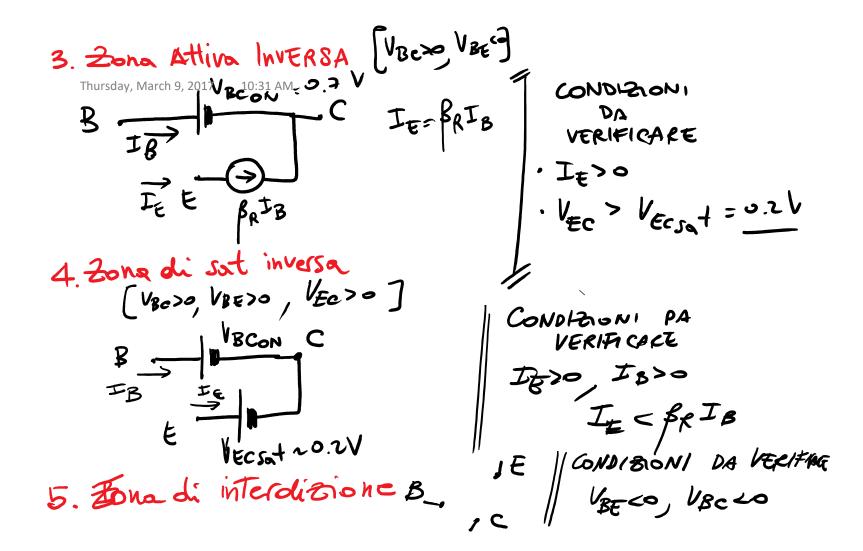
zona neutra nella

bose

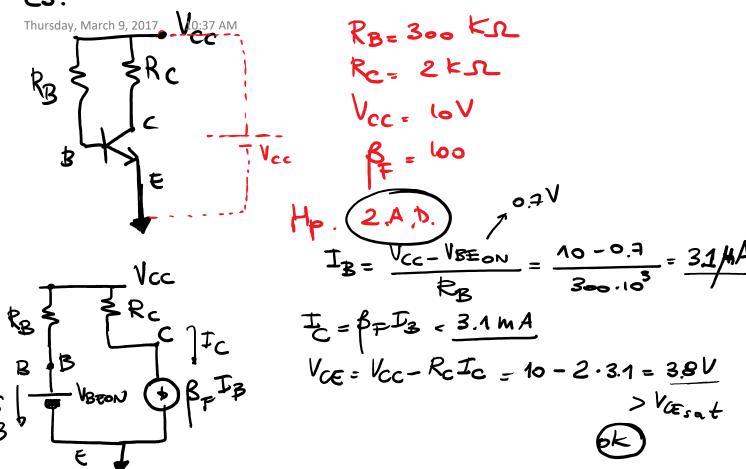
si riduce la ricombinazione in bose procumenta E-pres oumenta in finzione di V



Modello del BUT di grande segnale 1. Zona Attiva DIRETTA - VBE>0, VBC<0] \\ \(\langle \text{\alpha} \colon \text{\alpha} \text{\a NBE ON 2. Zona di Saturezione (DIRETTA) [VBE>0, VBE>0, VCE>0]
B.



Es.



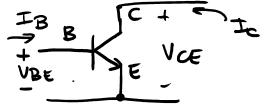
DIRETTA

$$I_{B} = 62 \mu A$$
 $I_{C} = \beta_{F} I_{B} = 6.2 \mu A$
 $V_{CE} = V_{CC} - R_{C} I_{C} = 10 - 2.6.2 = -2.4 V$

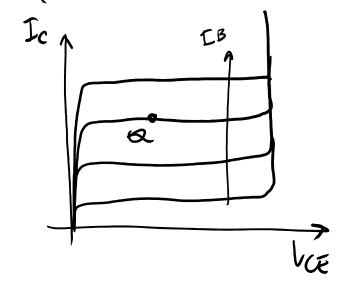
No

Circuito equivalente per il piccolo sezhale

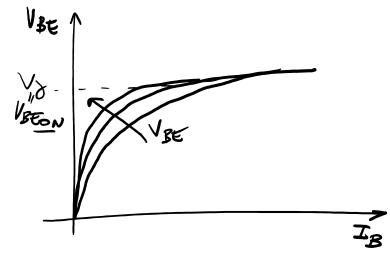
Thursday, March 9, 2017



CONF. EMETITIVEE COMUNE (Common Emitter CE)



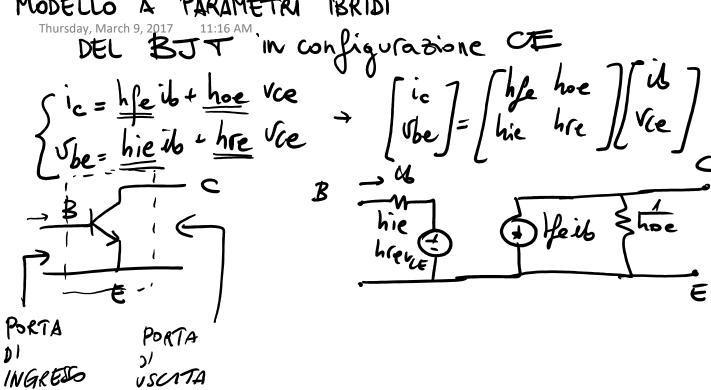
Caratteristiche di uscita Ic (VCE, IB)
Caratteristiche di inglesso
VBE (IB, VCE)

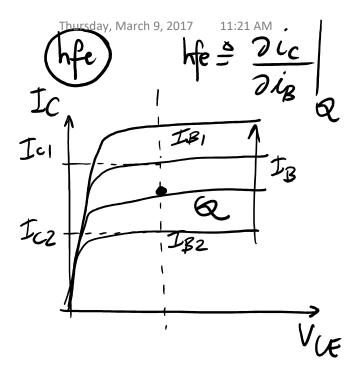


Espansione al l'ordine Thursday, March 9, 2017 11:06 AM
delle caratteristiche di uscita ic - Le (Vat, is) Ic+ic = 2 (Vae+ See IB+ib) =

ESPANSIONE AL 1 ORDINE DELLE CARATTERISTICHE DI INGRESSO JBE = JBE (1B, JCE) VBE+ The = JBE (IB+ ib, VOE+ Vice)

MODELLO A PARAMETRI IBRIDI





in 2.A.D.

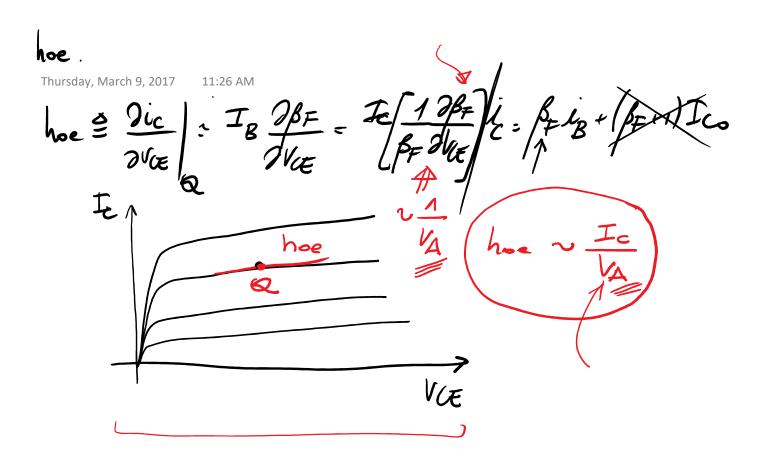
do I modello di EBERSe

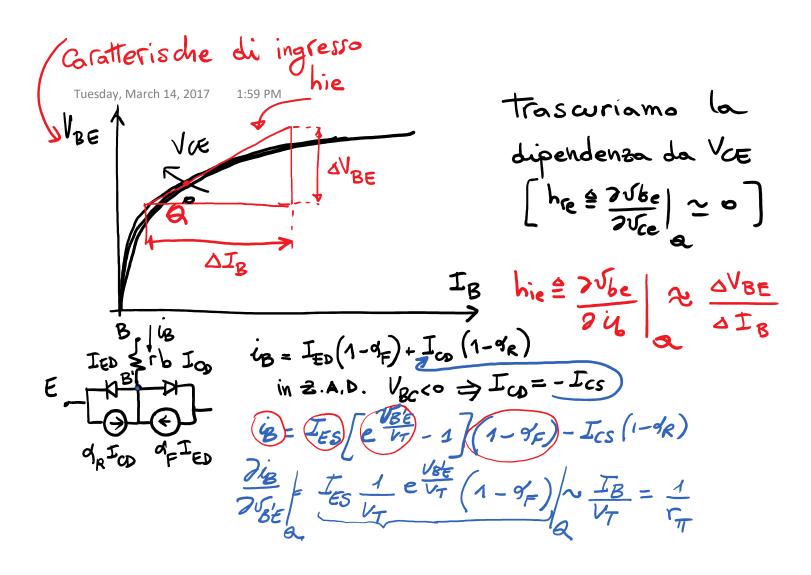
nocc

$$T_{c} = \beta_{F}T_{B+}(\beta_{F}+n)T_{co}$$

ic

 J_{g}
 J_{g}



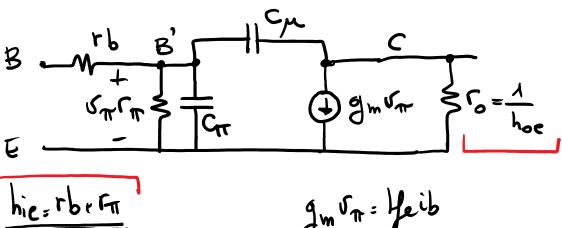


Tuesday, March 14, 2017
$$\frac{14}{9} \frac{2017}{8E} = \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$$

Capacità interne Tuesday, March 14, 2017 2:13 PM E Glunzione p.n. tra bose ed emethitore [in zona attiva diretta]
pol. direttamente] Giunzione p.n tra base e collettore (in 3.A.D. pol. inversamente) Obe ~ Cu in zona attiva diretta: Che> Che

Circuito equivalente di GNACOLETTO Tuesday, March 14, 2017 2:18 PM

del transistore



in continue
$$U : \frac{S_T}{r_T} = \frac{B}{V_T} = \frac{I_C}{V_T}$$

The second sec

